



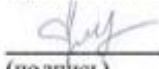
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»


(ДВФУ)

Институт наукоемких технологий и переловых материалов (Школа)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОП


(подпись) А.А. Саранин
(ФИО)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Физики
низкоразмерных структур
и наноматериалов

(подпись) А.А. Саранин
(ФИО.)
14 января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительные главы кристаллографии

Направление подготовки 11.04.04 Электроника и нанoeлектроника
магистерская программа

«Электроника и нанoeлектроника (совместно с ИАПУ ДВО РАН)»

Форма подготовки: очная

курс 1 семестр 2

лекции час.

практические занятия час.

лабораторные работы 54 час.

в том числе с использованием МАО лек. /пр. /лаб. час.

всего часов аудиторной нагрузки 54 час.

в том числе с использованием МАО час.

самостоятельная работа 54 час.

в том числе на подготовку к экзамену час.

контрольные работы (количество)

курсовая работа / курсовой проект семестр

зачет 2 семестр

экзамен семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и нанoeлектроника, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 959.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физики низкоразмерных структур, протокол № 5 от «14» января 2021 г.

Заведующий кафедрой: д.ф.-м.н., член-корр., профессор Саранин А.А

Составитель: к.ф.-м.н., профессор Крайнова Г.С.

Владивосток
2021

Оборотная сторона титульного листа РПД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Директор департамента: _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Директор департамента: _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Аннотация дисциплины «Дополнительные главы кристаллографии»

Учебная дисциплина «Дополнительные главы кристаллографии» предназначена для магистрантов 1 курса магистратуры 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, магистерской программы «Электроника и наноэлектроника (совместно с ИАПУ ДВО РАН)».

Дисциплина «Дополнительные главы кристаллографии» входит в часть формируемую участниками образовательных отношений цикла дисциплин образовательной программы, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.03.01), реализуется на 1 курсе во 2 семестре, завершается зачётом. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 З.Е. (108 часов). Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия (54 час.), самостоятельная работа студента (54 час.), зачет.

Язык реализации – русский.

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений о периодической и квазипериодической структурах на атомном уровне; овладение комбинативным подходом к изучению различных форм кристаллического вещества, необходимыми методами исследования кристаллических многогранников и структур.

Задачи:

- дать представление о современных проблемах кристаллографии, симметрии как инвариантности, саморавенстве объектов;
- сформулировать главные принципы структурообразования кристаллов;
- сформировать умение работать с квазипериодическими и модулированными структурами;
- ознакомление с базовыми понятиями геометрической кристаллографии, кристаллохимии, кристаллофизики;
- умение описывать кристаллов с помощью законов кристаллографии.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируется следующая профессиональная компетенция:

Тип задач	Код и наименование профессиональной компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Производственно-технологический	ПК-7 Способен разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники	ПК-7.1 определяет задачи проектирования технологического объекта, этапы проектирования изделий, составляющих основу компонентной базы электроники
		ПК-7.2 разрабатывает технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ПК-7.1 определяет задачи проектирования технологического объекта, этапы проектирования изделий, составляющих основу компонентной базы электроники	<i>Знает</i> алгоритм постановки задач проектирования технологического объекта, этапы проектирования изделий
	<i>Умеет</i> осуществлять проектирование технологического объекта или изделия, составляющего основу компонентной базы электроники
	<i>Владеет</i> навыками проектно-конструкторской деятельности электроники и нанoeлектроники
ПК-7.2 разрабатывает технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники	<i>Знает</i> состав проектной документации, совокупность документов, определяющих технологический процесс производства материалов и изделий электронной техники
	<i>Умеет</i> разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники, используя существующие нормативы и иные данные
	<i>Владеет</i> навыками разработки технических заданий и технологической документации для устройств, приборов и систем электронной техники подлежащих проектированию

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Лабораторные работы (54 часов)

Блок №1. Основные понятия кристаллографической геометрии (12 часов).

1. Подбор и изучение теоретического материала по темам блока 1.
2. Постановка задач, определение порядка выполнения заданий практической части. Обработка результатов выполненных заданий.

3. Формулировка описательной части, формулировка выводов, составление отчета.

4. Защита лабораторной работы: сдача краткой теории по теме работы, объяснение экспериментальных результатов.

Вопросы блока 1:

- 1). (r, R) – системы точек. Теорема о локальной правильности системы точек.
- 2). Разбиение пространства и методы их описания. Разбиение евклидовой плоскости – теория планигонов. Теория параллелепипедов и стереопипедов.
- 3). Непериодические разбиения. Мозаики Пенроуза.
- 4). Описание квазикристаллов и квазипериодических структур.

Блок №2. Внутреннее строение кристаллов (16 часов).

1. Подбор и изучение теоретического материала по темам блока 2.
2. Постановка задач, определение порядка выполнения заданий практической части. Обработка результатов выполненных заданий.
3. Формулировка описательной части, формулировка выводов, составление отчета.
4. Защита лабораторной работы: сдача краткой теории по теме работы, объяснение экспериментальных результатов.

Вопросы блока 2:

- 1). Пространственная решетка. Системы координатных осей. Понятие кристаллографической зоны. Уравнение зоны.
- 2). Понятие кристаллографического и полярного комплексов. Стереографическая проекция. Сетка Вульфа и приемы работы с ней.
- 3). Симметрия кристаллов. Преобразование координат при повороте вокруг оси. Преобразования координат при зеркальном отражении, инверсии.

- 4). Сложение элементов симметрии. Основные понятия теории групп.
- 5). Точечные группы симметрии.
- 6). Трансляционные группы. Группы Браве. Открытые симметричные преобразования. Сочетания трансляций и точечных элементов симметрии.

Блок №3. Грамматика формы и ее связь с кристаллографией (12 часов).

1. Подбор и изучение теоретического материала по темам блока 3.
2. Постановка задач, определение порядка выполнения заданий практической части. Обработка результатов выполненных заданий.
3. Формулировка описательной части, формулировка выводов, составление отчета.
4. Защита лабораторной работы: сдача краткой теории по теме работы, объяснение экспериментальных результатов.

Вопросы блока 3:

- 1). Структурно-кристаллографические разновидности простых форм.
- 2). Связь между структурой и внешней формой кристаллов. Простые формы кристаллов в классах низшей и средней категорий.
- 3). Простые формы кристаллов в классах высшей категории – кубической сингонии.

Блок №4. Основы кристаллохимии (14 часов).

1. Подбор и изучение теоретического материала по темам блока 4.
2. Постановка задач, определение порядка выполнения заданий практической части. Обработка результатов выполненных заданий.
3. Формулировка описательной части, формулировка выводов, составление отчета.
4. Защита лабораторной работы: сдача краткой теории по теме работы, объяснение экспериментальных результатов.

Вопросы блока 4:

- 1). Атомно-молекулярные модели роста кристаллов.
- 2). Основы кристаллохимии.
- 3). Координация атомов и ионов в структурах кристаллов. Координационные полиэдры.
- 4). Плотнейшие упаковки.
- 5). Изображение кристаллических структур. Типы структур. Изоморфизм в структурах. Полиморфизм, политипизм и псевдоморфизм в кристаллах.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

III. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Блок 1. Основные понятия кристаллографической геометрии	ПК-12	знает	Лабораторная работа 1 (ПР-6)	зачет, вопросы 1-4 Собеседование (УО-1)
			умеет	Отчет по лабораторной работе (ПР-6)	зачет, защита лабораторной работы Собеседование (УО-1)
			владеет	Собеседование (УО-1)	зачет, защита практических заданий

					Собеседование (УО-1)
2	Блок 2. Внутреннее строение кристаллов	ПК-12	знает	Лабораторная работа 2 (ПР-6) Тест 1 (ПР-1)	зачет, вопросы 5-10 Собеседование (УО-1)
			умеет	Коллоквиум 1 (УО-2) Домашнее задание (УО-1)	зачет, защита коллоквиума, домашнего задания Собеседование (УО-1)
			владеет	Контрольная работа 1, 2 (ПР-2)	зачет, защита контрольных работ Собеседование (УО-1)
3	Блок 3. Грамматика формы и ее связь с кристаллографией	ПК-12	знает	Лабораторная работа 3 (ПР-6)	зачет, вопросы 11-13 Собеседование (УО-1)
			умеет	Домашнее задание (ПР-6)	зачет, защита домашнего задания Собеседование (УО-1)
			владеет	Собеседование (УО-1)	зачет, защита практических заданий Собеседование (УО-1)
4	Блок 4. Основы кристаллохимии	ПК-12	знает	Лабораторная работа 4, 5 (ПР-6)	зачет, вопросы 14-18 Собеседование (УО-1)
			умеет	Коллоквиум 2 (УО-2)	зачет, защита коллоквиума Собеседование (УО-1)
			владеет	Контрольная работа (ПР-2)	зачет, защита контрольной работы Собеседование (УО-1)

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

IV. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Ю. К. Егоров-Тисменко. Кристаллография и кристаллохимия : учебник для вузов / [под ред. В. С. Урусова]. М: МГУ, 2014. – 587 с.
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:734049&theme=FEFU>
2. Белов Н.П., Покопцева О.К., Яськов А.Д. Основы кристаллографии и кристаллофизики. Часть I. Введение в теорию симметрии кристаллов: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. - 43 с.
<http://window.edu.ru/resource/335/63335>
3. Трушин В.Н., Андреев П.В., Фаддеев М.А. Рентгеновский фазовый анализ поликристаллических материалов. Электронное учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 89 с.
<http://window.edu.ru/resource/210/79>
4. Э.Э. Лорд, А. Л. Маккей, С. Ранганатан. Новая геометрия для новых материалов // Пер. с англ. под ред. В. Я. Шевченко, В. Е. Дмитриенко, М: Физматлит, 2010, 260 с.
<https://e.lanbook.com/book/48204>
5. Агеев О.А., Федотов А.А., Смирнов В.А. Методы формирования структур элементов наноэлектроники и наносистемной техники: Учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. - 72 с.
<http://window.edu.ru/resource/948/73948>

Дополнительная литература:

1. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2009. - 416 с. <http://www.iprbookshop.ru/12979.html>
2. Шевченко О.Ю. Основы физики твердого тела: учебное пособие / О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2010. — 77 с <http://www.iprbookshop.ru/67512.html>
3. Федотов А.К. Физическое материаловедение. Часть 1. Физика твердого: учебное пособие / А.К. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 400 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20161.html>
4. Орлова М.Н. Наноэлектроника [Электронный ресурс]: курс лекций/ Орлова М.Н., Борзых И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 50 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56246.html>
5. Астайкин А.И. Метрология и радиоизмерения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Астайкин А.И., Помазков А.П., Щербак Ю.П. – Электрон. текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2010. – 405 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18440.html> – ЭБС «IPRbooks».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Крайнова Г.С., Полянский Д.А., Писаренко Т.А. Виды симметрии кристаллических многогранников. Типы кристаллических решеток. Методические указания по курсу «Кристаллография и кристаллофизика» // Владивосток, ДВГУ, 2003, 32 с.
2. Крайнова Г.С., Кузнецов Р.Ю. Точечные группы симметрии. Методические указания к лабораторной работе // Владивосток, 2010, 22 с.
3. Электронный учебно-методический комплекс по теории симметрии // Владивосток, 2010.
4. Крайнова Г. С. Стереографическая проекция. Методические указания к лабораторной работе // Владивосток, 2010, 16 с.

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для проведения лабораторных работ по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии» и оформления отчетов может использоваться стандартное программное обеспечение компьютерных учебных классов (Windows XP, MicrosoftOffice и др.).

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет значительную часть времени изучаемого цикла (50%). Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у преподавателя дисциплины.

Главное в период обучения – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения исследований, связанных с выполнением практических заданий по дисциплине доступно лабораторное оборудование и специализированные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
690922, Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус L, ауд. L442	Специализированная лаборатория Департамента общей и экспериментальной физики: Лаборатория материаловедения и кристаллографии Лабораторные столы и стулья Количество посадочных рабочих мест для студентов - 8	Microsoft Office365/Microsoft/США/ Платное ПО Microsoft Teams/Microsoft/США/Платное ПО

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно - навигационной поддержки.

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1	1 - 4 недели	Подготовка отчета по лабораторной работе №1 Подготовка к устному опросу	12 час.	Защита отчетов
2	5 - 10 недели	Подготовка отчета по лабораторной работе 2 Подготовка к контрольным работам 1, 2 Подготовка у тесту 1 Выполнение домашнего задания	18 час.	Защита отчетов
3	11 - 13 недели	Подготовка отчета по лабораторной работе 3 Подготовка к собеседованию Выполнение домашнего задания	10 час.	Защита отчетов
4	14 - 18 недели	Подготовка отчета по лабораторным работам 4,5	14 час.	Защита отчетов

		Подготовка к коллоквиуму Подготовка к контрольной работе 3		
Итого			54 часа	

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Задания и методические рекомендации для самостоятельной работы обеспечивают подготовку отчетов к лабораторным работам. Их полное содержание приведено в программе и методических указаниях. Методические указания к лабораторным работам в электронном виде и печатном виде берутся у ведущего преподавателя.

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы отражаются в письменных работах (отчетах по лабораторным работам).

К представлению и оформлению отчетов по лабораторным работам предъявляются следующие требования.

Структура отчета по лабораторной работе

Отчеты по лабораторным работам представляются в электронной форме, подготовленные как текстовые документы в редакторе MSWord.

Отчет по работе должен быть обобщающим документом, включать всю информацию по выполнению заданий, в том числе, построенные диаграммы, таблицы, приложения, список литературы и (или) расчеты, сопровождая необходимыми пояснениями и иллюстрациями в виде схем, экранных форм («скриншотов») и т. д.

Структурно отчет по лабораторной работе, как текстовый документ, комплектуется по следующей схеме:

✓ *Титульный лист* – обязательная компонента отчета, первая страница отчета, по принятой для лабораторных работ форме (титульный лист отчета должен размещаться в общем файле, где представлен текст отчета);

✓ *Исходные данные к выполнению заданий*– обязательная компонента отчета, с новой страницы, содержат указание варианта, темы и т.д.);

✓ *Основная часть*– материалы выполнения заданий, разбивается по рубрикам, соответствующих заданиям работы, с иерархической структурой: разделы – подразделы – пункты – подпункты и т. д.

✓ Рекомендуется в основной части отчета заголовки рубрик (подрубрик) давать исходя из формулировок заданий, в форме отглагольных существительных;

✓ *Список литературы*– обязательная компонента отчета, с новой страницы, содержит список источников, использованных при выполнении работы, включая электронные источники (список нумерованный, в соответствии с правилами описания библиографии);

✓ *Приложения*– необязательная компонента отчета, с новой страницы, содержит дополнительные материалы к основной части отчета.

Набор текста

Набор текста осуществляется на компьютере, в соответствии со следующими требованиями:

✓ печать – на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (размер 210 на 297 мм.);

✓ интервал межстрочный – полуторный;

✓ шрифт – TimesNewRoman;

✓ размер шрифта - 14 пт., в том числе в заголовках (в таблицах допускается 10-12 пт.);

✓ выравнивание текста – «по ширине»;

✓ поля страницы -левое – 25-30 мм., правое – 10 мм., верхнее и нижнее – 20 мм.;

✓ нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы (для страниц с книжной ориентацией), сквозная, от титульного листа до последней страницы, арабскими цифрами (первой страницей считается титульный лист,

на котором номер не ставится, на следующей странице проставляется цифра «2» и т. д.).

✓ режим автоматического переноса слов, за исключением титульного листа и заголовков всех уровней (перенос слов для отдельного абзаца блокируется средствами MSWord с помощью команды «Формат» – абзац при выборе опции «запретить автоматический перенос слов»).

Рекомендации по подготовке к контрольной работе

Для успешного написания контрольных работ необходимо глубокое понимание основ рассматриваемых процессов, явлений, что обеспечивается систематической работой как на лабораторных занятиях, так и самостоятельно. Самостоятельная работа не менее важна, чем аудиторная.

Также в процессе подготовки к контрольным работам рекомендуется пользоваться литературой из списка основной и дополнительной литературы, Интернет-источниками.

Кроме того, теоретический материал можно почерпнуть из методических указаний в процессе выполнения лабораторных работ.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Оценивание лабораторных работ проводится по критериям:

- полнота и качество выполненных заданий;
- качество оформления отчета, использование правил и стандартов оформления текстовых и электронных документов;
- отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы.

Оценивание контрольных работ проводится по критериям:

- полнота и качество ответов на теоретические вопросы;

- отсутствие логических ошибок, связанных с пониманием материала;
- отсутствие ошибок в формулах, выражениях, характеризующих рассматриваемый процесс, явление;
- отсутствие значительных ошибок в приводимых количественных характеристиках.

Паспорт Фонд Оценочных Средств
Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели	баллы
ПК-12, способность разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники	Знает	<ul style="list-style-type: none"> - основные законы кристаллографии, точечные и трансляционные элементы симметрии, правила сложения элементов симметрии - связь внутренней кристаллической решетки с внешней формой кристаллов и их свойствами - установку и последовательность определения элементов симметрии кристаллов - правила работы с научной литературой по кристаллографии, кристаллохимии, кристаллофизики 	объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты	наличие общего представления о природе кристаллического состояния вещества; знание способов описания кристаллических структур, обладает базовыми навыками описания точечных групп и пространственной симметрии кристаллов	60-74
	Умеет	<ul style="list-style-type: none"> - составлять кристаллографическую характеристику кристаллов, диагностировать простые формы - обозначать виды симметрии (точечные группы) полными формулами и с помощью порождающих элементов симметрии - анализировать внутреннюю структуру кристаллов 	уметь систематизировать научную информацию, выполнять типовые задачи по анализу и синтезу кристаллических структур	Применять знания в области – составления кристаллографических характеристик кристаллов, диагностирования простых форм, обозначения видов симметрии (точечных групп) полными формулами и с помощью порождающих элементов симметрии,	75-89

				анализа внутренней структуры кристаллов	
	Владеет	- навыками кристаллографического анализа - методами расшифровки и выводом федоровских групп - методами представления кристаллических структур для проектирования производства новых материалов	уметь решать задачи в области анализа структуры кристаллов с определением точечной и пространственной группы, синтеза электрических цепей, владеть методами представления кристаллических структур, проектированием структур с заданными физическими свойствами	Способностью четко и грамотно ставить задачу, составлять план разработки кристаллографического анализа, методами расшифровки и выводом федоровских групп, методами представления кристаллических структур; владеет умением самостоятельно находить методы решения проектирования структур для производства новых материалов	90-100

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Текущая аттестация студентов

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии» проводится в форме защиты лабораторных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов, собеседования по домашним заданиям, контрольным работам и тестам.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

- результаты самостоятельной работы.

Оценивание результатов освоения дисциплины на этапе текущей аттестации проводится в соответствии с используемыми оценочными средствами и критериями.

Критерии оценки отчетов по лабораторным работам, домашним заданиям, тестам

Оценивание работ проводится при представлении отчета в электронном или печатном виде, по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он представляет к защите отчет по работе, удовлетворяющий требованиям по поставленным заданиям, по оформлению, демонстрирует владение методами и приемами теоретических и практических аспектов работы.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не владеет методами и приемами теоретических и практических аспектов работы, допускает существенные ошибки в работе, представляет отчет с существенными отклонениями от правил оформления письменных работ.

Промежуточная аттестация студентов

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии» проводится в виде зачета, форма зачета- «устный опрос в форме ответов на вопросы», «практические задания по типам». Допуск к зачету возможен после защиты отчетов по всем лабораторным работам курса.

**Критерии выставления оценки «зачтено» студенту по дисциплине
«Дополнительные главы кристаллографии»:**

Оценка (стандартная)	Требования к сформированным компетенциям
«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами вопросами и другими видами применения знаний; применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

(Собеседование УО-1)

Вопросы к зачету

1. (r, R) – системы точек. Теорема о локальной правильности системы точек.
2. Разбиение пространства и методы их описания. Разбиение евклидовой плоскости – теория планигонов. Теория параллелоэдров и стереоэдров.
3. Непериодические разбиения. Мозаики Пенроуза.
4. Описание квазикристаллов и квазипериодических структур.
5. Пространственная решетка. Системы координатных осей. Понятие кристаллографической зоны. Уравнение зоны.
6. Понятие кристаллографического и полярного комплексов. Стереографическая проекция. Сетка Вульфа и приемы работы с ней.

7. Симметрия кристаллов. Преобразование координат при повороте вокруг оси. Преобразования координат при зеркальном отражении, инверсии.
8. Сложение элементов симметрии. Основные понятия теории групп.
9. Точечные группы симметрии.
10. Трансляционные группы. Группы Браве. Открытые симметричные преобразования. Сочетания трансляций и точечных элементов симметрии.
11. Структурно-кристаллографические разновидности простых форм.
12. Связь между структурой и внешней формой кристаллов. Простые формы кристаллов в классах низшей и средней категорий.
13. Простые формы кристаллов в классах высшей категории – кубической сингонии.
14. Атомно-молекулярные модели роста кристаллов.
15. Основы кристаллохимии.
16. Координация атомов и ионов в структурах кристаллов. Координационные полиэдры.
17. Плотнейшие упаковки.
18. Изображение кристаллических структур. Типы структур. Изоморфизм в структурах. Полиморфизм, политипизм и псевдоморфизм в кристаллах.

**Оценочные средства для текущей аттестации
Темы коллоквиумов.**

Коллоквиум 1. Симметрия кристаллов.

Вопросы.

1. Покажите на рисунке, какими основными трансляциями характеризуется кубическая объёмцентрированная решетка? Чему равен период повторяемости этой решетки в направлении $[110]$, $[120]$, $[310]$, если период повторяемости в направлении $[100]$ равен a ?
2. Покажите на рисунке, какими основными трансляциями характеризуется кубическая гранецентрированная решетка? Чему равен

период повторяемости этой решетки в направлениях [111], [101], [121], если период повторяемости в направлении [001] равен a ?

3. Покажите на рисунке, какими основными трансляциями характеризуется ромбическая базоцентрированная решетка? Чему равен период повторяемости этой решетки в направлениях [120], [012], [112], если период повторяемости в направлениях [100], [010] [001] равны соответственно a , b , c ?

4. Сделайте проекцию нескольких смежных ячеек тетрагональной объемноцентрированной решетки на плоскости (100) и (001). Рассчитайте расстояние между ближайшими узловыми сетками серий $\{110\}$ и $\{011\}$, если периоды повторяемости решетки в направлениях [100] и [001] равны, соответственно 3,2 и 5,6.

5. Изобразите в виде ортогональной проекции на горизонтальную плоскость некоторую вертикальную плоскость скользящего отражения типа c вместе с системой точек, связываемых с этой плоскостью, представив, что некоторая исходная точка имеет нулевую координату по вертикальной оси Z .

6. Покажите в виде проекции на горизонтальную плоскость систему точек, связанную вертикальной винтовой осью симметрии 4_1 , обозначая каждую точку координатой по оси Z .

7. Расшифруйте записанные пространственные группы: $Ra3$, $R6_3/mmc$, $I422$, $Cmcm$, $F222$, $P2_13$.

8. Изобразите в проекции на плоскость (011) пространственную группу

$P4$. выведите правильные системы точек с координатами: $\frac{1}{4} 00$, $\frac{1}{4} \frac{1}{4} 0$, $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ и определите их кратность.

9. К какому классу может относиться шестигранный тетрагональный кристалл?

10. Объяснить, почему есть кристаллографические классы C_{2v} , C_{3v} , C_{4v} , C_{6v} и классы D_{2d} и D_{3d} , но нет классов D_{4d} и D_{6d} ?

11. Перечислить гемидрические группы для сингонии, голоэдрическая группа которой D_{6h} . какая из этих групп является гемиморфной?

12. Назвать гемидрическую и гемиморфную группу для сингонии, одна из гемидрических групп которой – 422.

13. Записать символы осей 2-го порядка в классах 222, 422, 32 и 432.

14. Записать символы трех любых ребер, параллельных грани (211).

15. У некоторого кристалла был изменен базис таким образом, что индексы плоскостей (100) и (010) остались без изменения, а индексы плоскостей $(\bar{1}01)$ стали (001). Какие индексы в новом базисе получили плоскости (011) и (121)? Какие индексы в новом базисе имеет старая координатная ось x?

16. В кристаллической решетке перешли к новому базису, заданному кратчайшими трансляциями в направлениях узловых рядов [011], [101], [110]. Как изменятся при этом индексы узлового ряда [111] и плоскости (111)?

Коллоквиум 2. Описание некоторых кристаллических структур.

Вопросы.

1. Проекция ячейки Браве на плоскость
2. Тип решетки кристалла (с обоснованием)
3. Число формульных единиц (Z)
4. Координационное число и координационный многогранник (для каждого сорта атомов)
5. Характер структуры и тип связей
6. Описание в терминах плотной упаковки шаров, если оно возможно

7. Структурный класс

8. N – число атомов, приходящихся на ячейку.

Типовые задания к лабораторным работам

Лабораторная работа № 1.

Некристаллографические группы симметрии.

Задание:

- построить группу симметрии, приняв за генераторы поворот вокруг оси второго порядка и отражение в плоскости симметрии, составляющей с осью угол $22,5^{\circ}$;
- построить стереографическую проекцию элементов симметрии группы, записать ее обозначение по Шенфлису и Герману-Могену;
- записать групповое множество, указать порядок группы;
- перечислить подгруппы.

Примеры тестовых заданий

Контрольная работа 1

Вариант 1

1. Записать стандартными международными символами точечные группы: $\frac{2}{m}$ mm, $\bar{4}$ mm.

2. Определить порядок групп 23 , $\frac{4}{m}$. Перечислить операции симметрии.

3. Перечислить классы симметрии (точечные группы) низшей категории, являющиеся подгруппами класса 622 .

4. Построить групповое множество, квадрат Кейли, приняв за генераторы

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Построить групповое множество, квадрат Кейли, приняв за генераторы

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Записать матрицу преобразования операции симметрии в кристаллографической системе координат и определить какого рода эта операция: m_{xy} .

7. Записать квадрат Кейли для группы 32.

8. Записать элементы группового множества для групп D_3 .

9. Указать порядок точечных групп симметрии D_{6h} , D_{2d} .

10. Какая точечная группа симметрии получится, если к групповому множеству указанной группы добавить новую операцию симметрии: в группе $mm2$ – отражение в плоскости, перпендикулярной оси второго порядка.

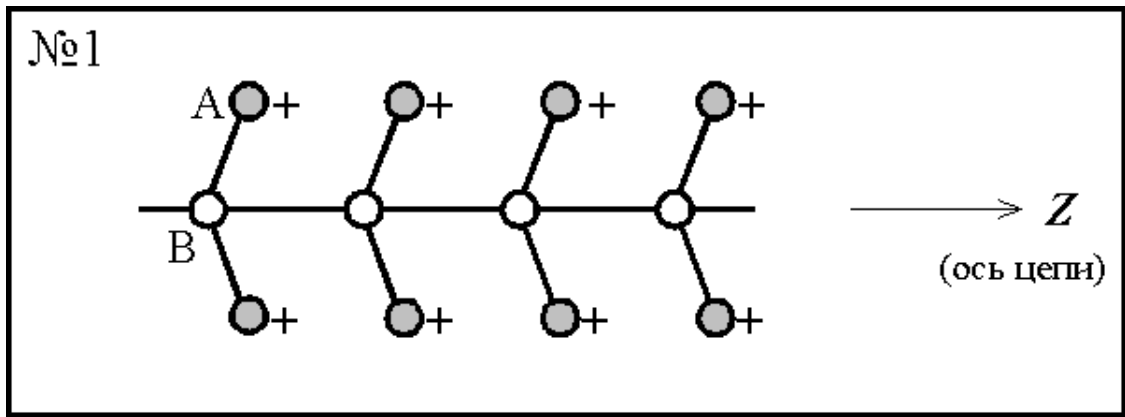
11. Какие симметричные преобразования связывают следующие грани кристалла (hkl) и $(kh\bar{l})$?

Контрольная работа 2

Записать структурные классы:

цепи или слоя и кристаллической структуры проекции которых показаны на рисунках. В обоих случаях рассмотреть два варианта: А и В - атомы разных элементов, А и В - атомы одного элемента. Указать тип решетки (дать пояснения).

Обоснованием решения является изображение расположения важнейших элементов симметрии на фоне расположения атомов. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях для сопоставления построенного рисунка со стандартным изображением группы необходимо перенести начало координат. Нужно также учесть, что для простоты часто изображаются не все элементы симметрии, входящие в группу, а лишь "порождающие" (указанные в символе группы) и центры инверсии



Контрольная работа 3

Вариант 1

1. Кристаллографическая система координат. Введите понятие кристаллографических реперов.
2. Кристаллографические реперы кристаллов средней и высшей категории.
3. Дайте определение примитивной и непримитивной элементарной ячейки. Приведете примеры, укажите группы трансляций.
4. Перечислите решетки Бравэ 7 сингоний кристаллов.
5. Введите понятие пространственной группы симметрии.
6. Запишите пространственные группы симметрии планального вида симметрии моноклинной сингонии.
7. Виды плотнейшей упаковки шаров: трехслойные и двухслойные структуры.
8. Структура α -Fe (пространственная группа $Im\bar{3}m$).
9. Дайте понятие координационного числа и координационного многогранника. Какой координационный многогранник соответствует координационному числу 8?
10. Структура рутила TiO_2 (пространственная группа $P4/mmm$).
11. Структура алмаза.

Тест по дисциплине «Дополнительные главы кристаллографии»

Вариант 1

1. Какую операцию симметрии необходимо добавить к перечисленным операциям симметрии, чтобы получилась группа: а) $\{e, 2_x, m_z, \dots\}$; б) $\{2_x, 2_y, 2_u, 3^1, 3^2, \dots\}$; в) $\{e, 2, 4^1, \dots\}$.
2. Показать эквивалентность зеркально-поворотной оси третьего порядка и инверсионной оси шестого порядка.
3. Записать квадрат Кейли для точечной группы C_{2h} .
4. Нарисовать стереографические проекции элементов симметрии точечных групп: C_3, S_4, C_{6h} .
5. Записать символ Шенфлиса и международный символ точечных групп, заданных кристаллографической формулой симметрии: а) $3L_2, L_22P, 3L_23PC$; б) $L_6, L_66L_2, L_66P, L_3P, L_33L_24P$.
6. Вывести группу симметрии, приняв за генераторы операции отражения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях симметрии и поворот вокруг оси второго порядка, перпендикулярной к одной из плоскостей. Изобразить элементы симметрии на стереографической проекции, дать обозначения группы в международной символике, записать обозначение по Шенфлису. Записать элементы группового множества.

Домашнее задание № 1

4.4. На рис. 4.3 приведены проекции элементарных ячеек тетрагональных кристаллов. Определить тип решеток Бравэ.

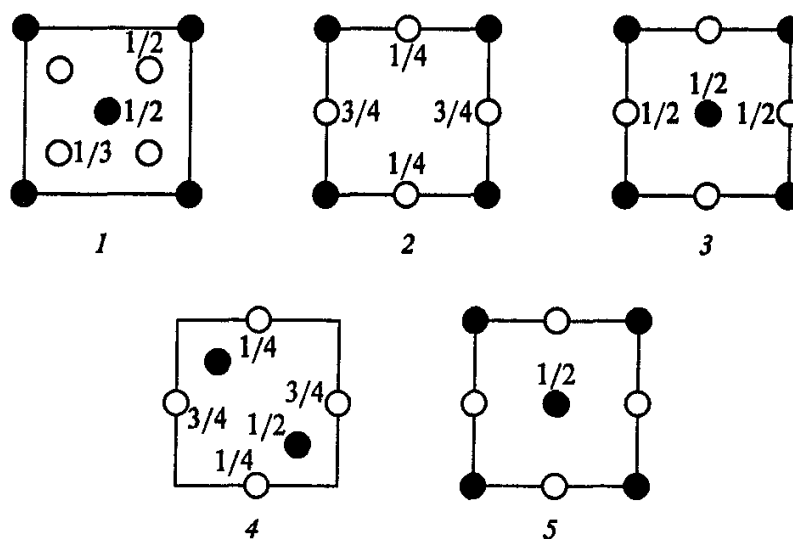


Рис. 4.3. К задаче 4.4